

<p>NPN型 小功率 贴片三极管 NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR SMD</p>	<p><b>HSC945</b> <b>HSC945LT1</b> NPN, BEC General Purpose Transistors</p> <p>对应其他工业型号 C945 2SC945 C945LT1 HSC945LT1 MMBT945LT1</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent hFE linearity</li> <li>■ Low noise</li> <li>■ Complementary to A733</li> <li>■ Transistor Polarity: NPN</li> <li>■ Transistor pinout: BEC</li> <li>■ SOT-23 Package</li> <li>■ Marking Code: CR</li> <li>■ hFE: 120~200, 200~400</li> </ul>	

<p>Inner circuit</p>  <p>SOT-23 内部结构</p>	<p>HSC945</p>  <p>1. Base 2. Emitter 3. Collector</p> <p>SOT-23 管脚排列</p>	<p>元件标识 (打印)</p>  <p>DEVICE MARKING: ↓</p>
--	--	--

■ DEVICE MARKING 元件标识 (打印) 对应放大系数

HSC945LTI	L	H	K
MARKING	CRL	CRH	CRK
hFE	120~200	200~400	300~600

■ MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	$V_{CBO}$	60	V
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	$V_{CEO}$	50	
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	$V_{EBO}$	5.0	
Collector Current-Continuous 集电极电流-连续	$I_C$	100	mA
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	$P_C$	225	mW
Junction Temperature 结温	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range 储存温度	$T_{stg}$	-55~+150	



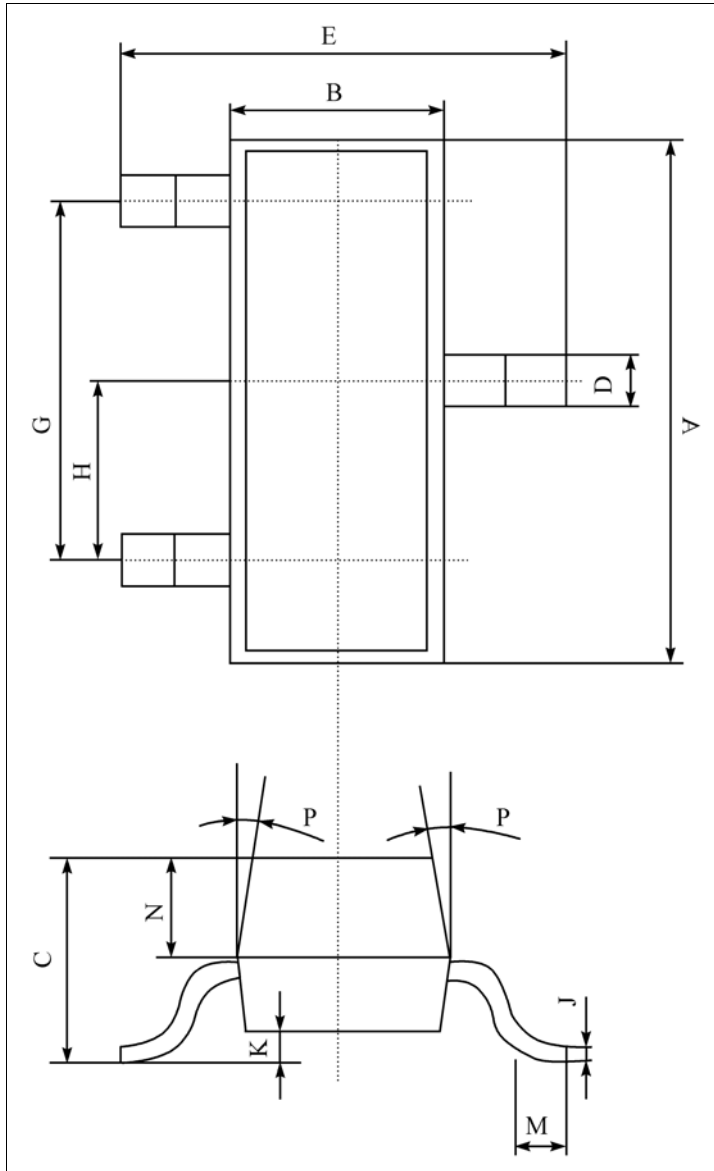
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	$I_{CBO}$	$I_E=0$ $V_{CB}=60V$	--	--	0.1	$\mu\text{A}$
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	$I_{EBO}$	$I_C=0$ $V_{EB}=5V$	--	--	0.1	
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	60	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	50	--	--	
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	5	--	--	
DC Current Gain 直流电流增益	hFE	$V_{CE}=6V$ $I_C=1\text{mA}$	120	--	400	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=10\text{mA}$	--	--	0.3	V
Base-Emitter Saturation 基极-发射极电压	$V_{BE}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10\text{mA}$	--	--	0.8	
Transition Frequency 特征频率	$f_T$	$V_{CE}=6V$ $I_C=1\text{mA}$	--	250	--	MHz

■ DIMENSION 外形封装尺寸数据

Package: SOT-23 HAOHAI Package Code: MM

单位 (UNIT) : mm



序号	数值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.20
N	0.60±0.10
P	7±2°
<p>Packing SOT-23 包装规格 SMD片式表面贴封装 包装方式: 载带卷盘包装 Tape &amp; Reel, 3Kpcs/Reel 每卷数量3000只 (3Kpcs/Reel) 每盒数量30000只 (30Kpcs/BOX) 每箱数量300000只 (300Kpcs/Cartons)</p>	



经中华人民共和国工商行政管理总局商标局批准  
HAOHAI、HHE 图案、字母、均为我公司正式注册商标，仿冒、盗用均属侵权，违法必究！

## 深圳市浩海电子有限公司

SHENZHEN HAOHAI ELECTRONICS CO., LTD.

2 floor(whole floor), BAOXIN Building. 0 Lane on the 8th. Yufeng Garden.  
82 District. BAOAN District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

中国 广东省 深圳市 宝安区 82区 裕丰花园 零巷8号 宝馨楼 二楼 (全层)

公司电话 TEL: +86-755-29955080、29955081、29955082、29955083  
总机八线 29955090、29955091、29955092、29955093

FAX: +86-755-27801767

E-mail: [kkg@kkg.com.cn](mailto:kkg@kkg.com.cn)

产品主页 <http://www.szhhe.com>

<http://www.kkg.com.cn>